

Silicon Diode

BYT52D

200V / 1,4A

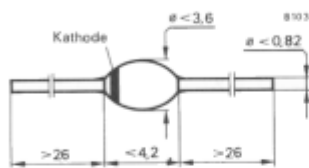
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BYT 52.**Silizium-Mesa-Dioden****Anwendungen:** Schnelle Gleichrichter und Schalter**Besondere Merkmale:**

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse
- Niedrige Sperrströme
- Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm

Sinterglasgehäuse
SOD 57
Gewicht max. 0,5 g

Bestempellung: Klartext**Absolute Grenzdaten**

Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYT 52 A	$U_{R'} U_{RRM}$	50	V
BYT 52 B	$U_{R'} U_{RRM}$	100	V
BYT 52 D	$U_{R'} U_{RRM}$	200	V
BYT 52 G	$U_{R'} U_{RRM}$	400	V
BYT 52 J	$U_{R'} U_{RRM}$	600	V
BYT 52 K	$U_{R'} U_{RRM}$	800	V
BYT 52 M	$U_{R'} U_{RRM}$	1000	V

Stoßdurchlaßstrom

$t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	20	A
-----------------------	-----------	----	---

Durchlaßstrom, Mittelwert	Fig. 2, 4 I_{FAV}	0,85	A
$I = 10 \text{ mm}, T_L = 25 \text{ °C}$	Fig. 3 I_{FAV}	1,4	A

Sperrschichttemperatur	T_j	175	°C
------------------------	-------	-----	----

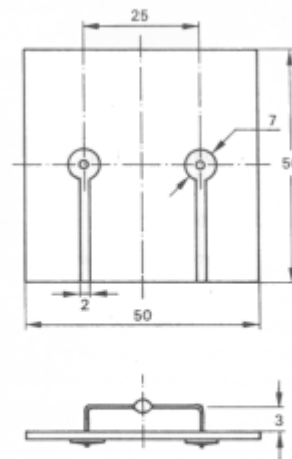
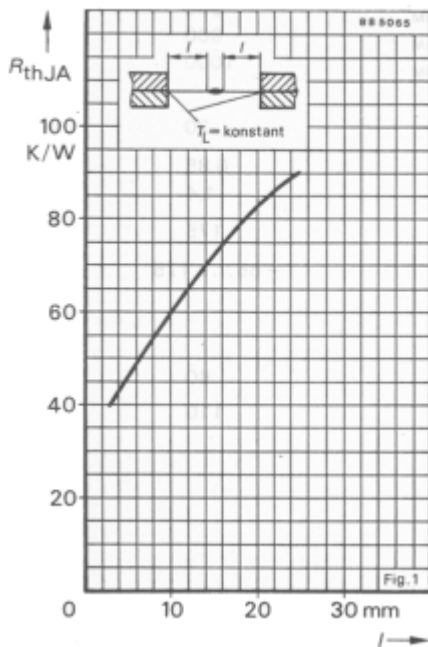
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 175	°C
----------------------------	-----------	----------------	----

Maximale Wärmewiderstände

Sperrschicht-Umgebung			
$I = 10 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	Fig. 1 R_{thJA}	60	K/W
auf Leiterplatte im Raster 25 mm	Fig. 2 R_{thJA}	110	K/W

BYT 52.

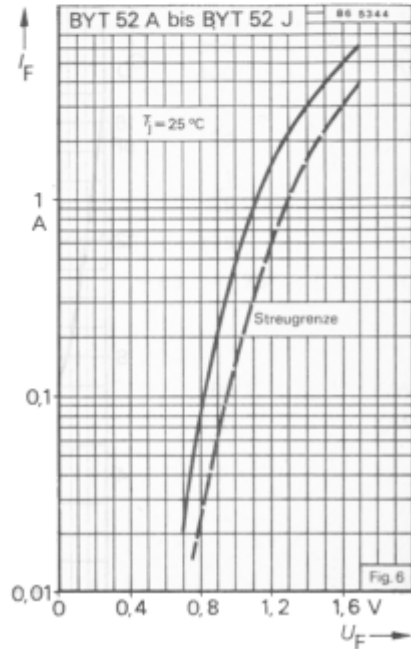
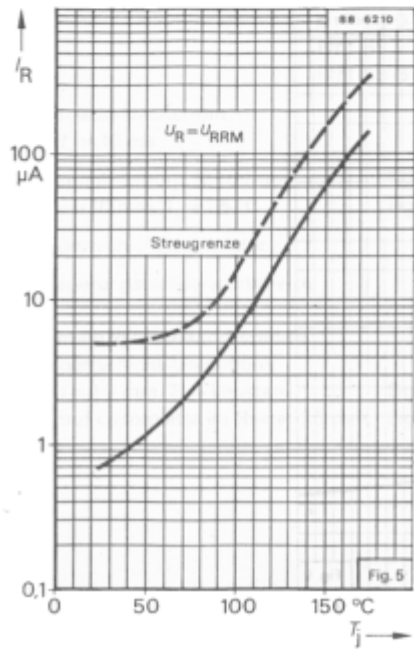
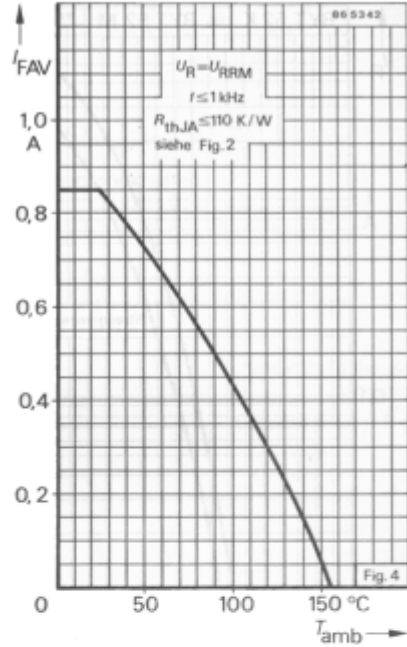
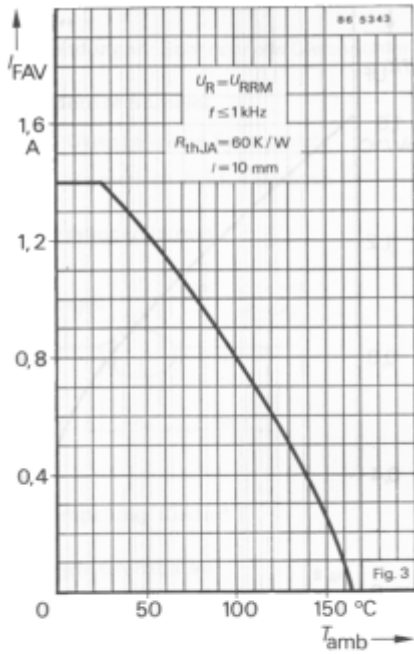
Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 1\text{ A}$	BYT 52 A...BYT 52 J	U_F		1,3 V
$I_F = 1\text{ A}$	BYT 52 K, BYT 52 M	U_F		1,4 V
Sperrstrom				
$U_R = U_{RRM}$		I_R		5 μA
$U_R = U_{RRM'}$	$T_j = 150\text{ °C}$	I_R		150 μA
Rückwärtserholzeit				
$I_F = 0,5\text{ A}$, $I_R = 1\text{ A}$, $i_R = 0,25\text{ A}$		t_{rr}		200 ns



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 110\text{ K/W}$

Fig 2 86 3497

BYT 52.



BYT 52.

